

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 21 年 4 月 2 日 (2009.4.2)

【公表番号】特表 2008-530312 (P2008-530312A)
 【公表日】平成 20 年 8 月 7 日 (2008.8.7)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-031
 【出願番号】特願 2007-555373 (P2007-555373)
 【国際特許分類】

C 0 8 L 101/00 (2006.01)
 C 0 8 L 83/04 (2006.01)
 C 0 8 L 83/02 (2006.01)
 B 0 1 J 20/18 (2006.01)
 B 0 1 J 3/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 101/00
 C 0 8 L 83/04
 C 0 8 L 83/02
 B 0 1 J 20/18 E
 B 0 1 J 3/00 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 21 年 2 月 10 日 (2009.2.10)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

P O S S 及び P O S からなる群より選択されるナノ構造材料で、ゼオライト若しくは分子篩の内部表面を被覆することを含むゼオライト若しくは分子篩の透過性の調整方法であって、ゼオライト若しくは分子篩の気体分離特性が、被覆の結果変性されものである、方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の方法であって、ゼオライト若しくは分子篩は、無溶媒技術及び超臨界流体支援技術から成る群より選択される技術を使用して、ナノ構造材料で被覆される方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の方法であって、その技術が、溶融状態処理法、噴霧処理法、流動処理法及び混合処理法から成る群より選択される処理方法である方法。

【請求項 4】

請求項 1 記載の方法であって、ナノ構造材料が、P O S S - シラノール、式 $[(R Si O_{1.5})_4 (R^1 X Si O_{1.0})_3]_7$ のシロキサイド、ポリシルセスキオキサン $[(R Si O_{1.5})_n]_{\#}$ 及び P O S S 断片 $[(R Si O_{1.5})_m (R^1 X Si O_{1.0})_n]_{\#}$ から成る群より選択される化合物由来であり、ここで、R と R¹ は、有機置換基を表し、同一か異なることができ、X は、官能基であり、m 及び n は、式の化学量論を表し、は、ナノ構造を表し、# は、ナノ構造内に含まれる珪素原子の数を表す、方法。